

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【公開番号】特開2008-269583(P2008-269583A)

【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-044

【出願番号】特願2008-60358(P2008-60358)

【国際特許分類】

G 06 K 19/077 (2006.01)

H 01 L 27/04 (2006.01)

H 01 L 21/822 (2006.01)

H 04 B 5/02 (2006.01)

【F I】

G 06 K 19/00 K

H 01 L 27/04 F

H 01 L 27/04 B

H 04 B 5/02

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月31日(2011.1.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

定電圧を生成する回路と、フィルタと、フィードバック回路と、を有し、

前記定電圧を生成する回路の出力は、前記フィルタを介して前記フィードバック回路の

入力に電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、

回路部を有し、

前記定電圧を生成する回路の出力は、前記回路部の入力に電気的に接続され、

前記回路部の入力は、前記フィルタを介して前記フィードバック回路の入力に電気的に

接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項1又は請求項2において、

交流信号から直流電圧を生成する入力回路を有し、

前記入力回路の出力は、前記定電圧を生成する回路の入力に電気的に接続されているこ  
とを特徴とする半導体装置。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、

前記フィルタは、容量素子と、第1の抵抗素子又はインダクタ素子から構成される第1  
の素子と、を有し、

前記フィードバック回路は、トランジスタと、第2の抵抗素子から構成される第2の素  
子と、を有し、

前記定電圧を生成する回路の出力は、前記第1の素子の一端及び前記容量素子の一端に  
電気的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第1の素子の他端に電気的に接続され、  
前記トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第2の素子の一端に電気的に接続され、

前記トランジスタのソース又はドレインの他方及び前記容量素子の他端は、低電源電位が印加される配線に電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

**【請求項5】**

請求項4において、

アンテナを有し、

前記アンテナの一端は、前記第2の素子の一端に電気的に接続されており

前記アンテナの他端は、前記低電源電位が印加される配線に電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

**【請求項6】**

請求項1乃至請求項5のいずれか一項において、

複数のトランジスタを有する素子群と、前記素子群が貼り付けられた曲面を有する基板と、を有し、

前記定電圧を生成する回路と前記フィルタと前記フィードバック回路とは、前記素子群を用いて形成されており、

前記複数のトランジスタのキャリアの移動方向が前記曲面が弧を描く方向と直交するよう、前記素子群が前記基板に貼り付けられていることを特徴とする半導体装置。